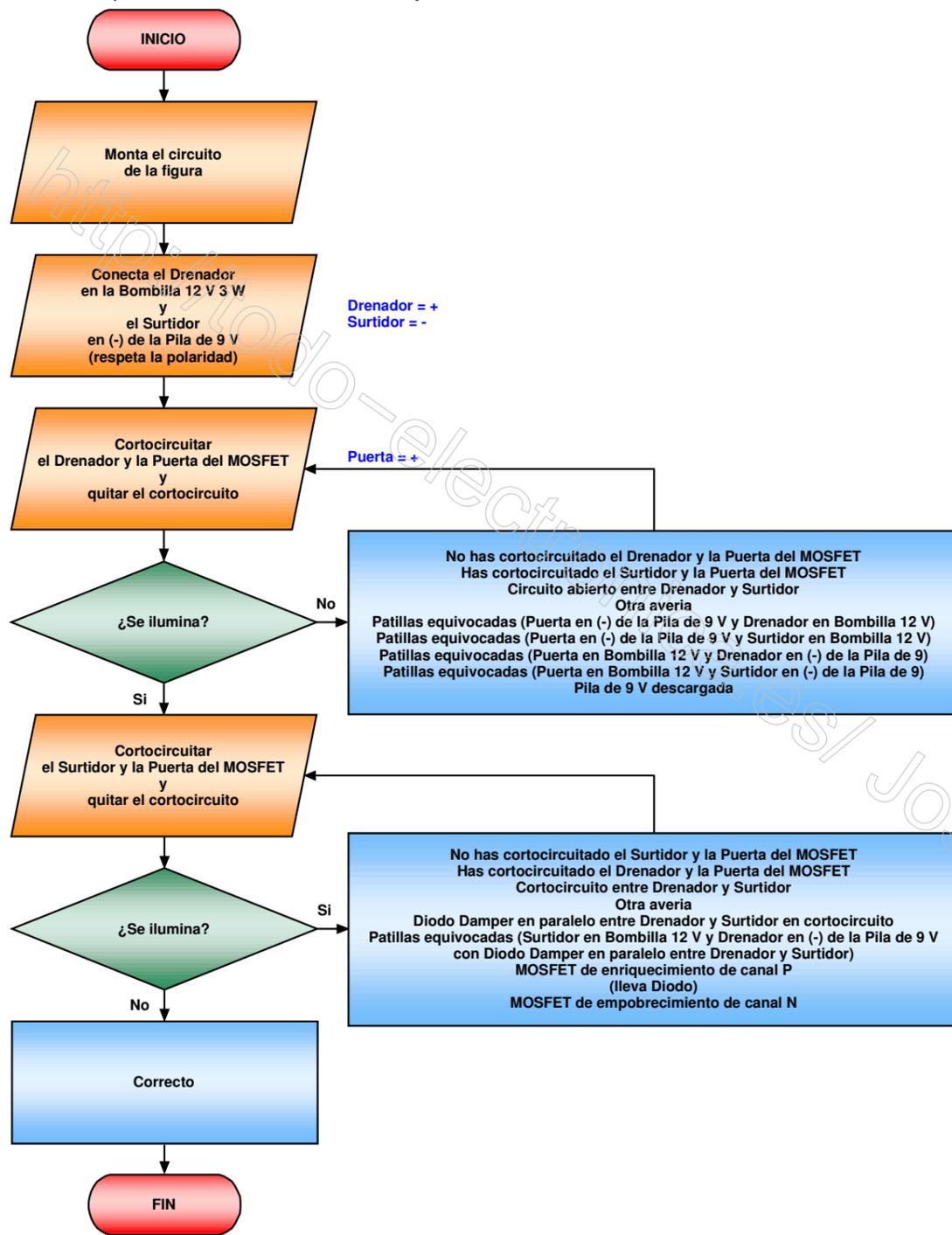
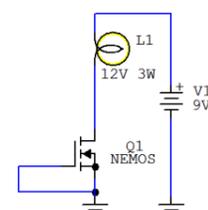
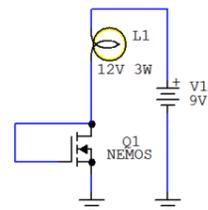
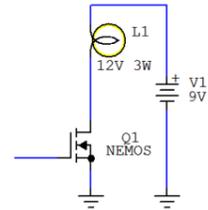
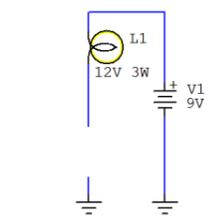


Comprobación de un Transistor MOSFET de enriquecimiento de canal N con una Pila de 9 V y una Bombilla 12 V



Drenador = +
Surtidor = -

Puerta = +

crea un canal de conducción y conduce entre Surtidor y Drenador

Para cargar la capacidad interna tienes seis métodos:

1. Cortocircuitar entre Drenador y la Puerta (nivel de iluminación: bajo).
2. Resistencia entre Drenador y la Puerta (nivel de iluminación: bajo).
3. Dedo entre Drenador y la Puerta (nivel de iluminación: bajo).
4. Cortocircuitar entre (+) Pila de 9 V y la Puerta (nivel de iluminación: alto).
5. Resistencia entre (+) Pila de 9 V y la Puerta (nivel de iluminación: alto).
6. Dedo entre (+) Pila de 9 V y la Puerta (nivel de iluminación: alto).

desaparece el canal de conducción y no conduce entre Surtidor y Drenador

Para descargar la capacidad interna tienes tres métodos:

1. Cortocircuitar entre Surtidor y la Puerta.
2. Resistencia entre Surtidor y la Puerta.
3. Dedo entre Surtidor y la Puerta.

Notas:
Este metodo es mejor.
Puedes quitar la Bombilla y sustituir por una Resistencia y el Diodo LED.

José Antonio Sánchez Castillo